PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-239847

(43)Date of publication of application: 11.09.1998

(51)Int.CI.

G03F 7/039 G03F 7/039 H01L 21/027

(21)Application number: 09-046000

(71)Applicant: FUJI PHOTO FILM CO LTD

(22)Date of filing:

28.02.1997

(72)Inventor: AOSO TOSHIAKI

SATO KENICHIRO

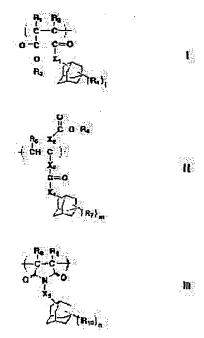
TAN SHIRO

(54) POSITIVE PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positive photosensitive composition adapted to exposure to short wavelength light and enhanced in sensitivity and resolution and resistance to dry etching and solubility in solvents by using a resin having repeating structural units having a specified alicycle ggand an acid—decomposable group.

SOLUTION: This positive photosensitive composition contains a compound to be allowed to release an acid by irradiation with activated rays or radiation and the resin having at least one of the groups increased in solubility in an alkaline developing solution by being decomposed by action of an acid and at least one of groups having adamantly groups represented by formulae I–III in which each of R1, R2, R5, R8, and R9 is an H or halogen atom or a cyano group or the like; each of R4, R7, and R10 is a halogen atom or a cyano group or substituent; and each of R3, R7, and R11 is an H atom or an alkyl or a cyclic or polycyclic cycloalkyl group or the like.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-239847

(43)公開日 平成10年(1998) 9月11日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	FI	
G03F 7/03	39 601	G03F 7/039	601
	5 0 1		501
H01L 21/02	27	H 0 1 L 21/30	5 0 2 R

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 39 頁)

(21)出願番号	特顯平9-46000	(71)出題人 000005201
(22)出願日	平成9年(1997)2月28日	富士写真フイルム株式会社 神奈川県南足柄市中沼210番地
		(72)発明者 青合 利明 静岡県様原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
		(72)発明者 佐藤 健一郎 静岡県榛原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
		(72)発明者 丹 史郎 静岡県棟原郡吉田町川尻4000番地 富士写 真フイルム株式会社内
		(74)代理人 弁理士 萩野 平 (外3名)

(54) 【発明の名称】 ポジ型感光性組成物

(57)【要約】

【課題】 250 n m以下、特に220 n m以下の波長の露光光源の使用に好適であり、具体的には250 n m以下、特に220 n m以下の波長の露光光源の使用時に、良好な感度、解像度を与え、更に十分な耐ドライエッチング性を有し、且つ溶剤溶解性が良好なポジ型感光性組成物を提供する。

【手段】 活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物及び特定の構造のアダマンチル基を有する繰り返し構造単位の少なくとも一つと、酸の作用により分解してアルカリ現像液中での溶解性を増大させる基の少なくとも一つを有する樹脂を含有するポジ型感光性組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)活性光線又は放射線の照射により酸を発生する化合物、及び(B)下記一般式(I)、

(II) 又は(III) で表されるアダマンチル基を有する繰り返し構造単位の少なくとも一つと、酸の作用により分 *

*解してアルカリ現像液中での溶解性を増大させる基の少なくとも一つを有する樹脂を含有することを特徴とするポジ型感光性組成物。

【化1】

式(I)~(III)中、R1、R2、R5、R8、R 9 は、同じでも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原 子、シアノ基、アルキル基又はハロアルキル基を表す。 R4、R7、R10は、同じでも異なってもよく、ハロゲ ン原子、シアノ基、置換基を有していても良い、アルキ ル基、アルケニル基もしくはアルキニル基、又は一CO -O-R₁₁基を表す。R₃、R₆、R₁₁は、同じでも異 なってもよく、水素原子、置換基を有していても良い、 アルキル基、単環あるいは多環のシクロアルキル基もし くはアルケニル基、又は酸の作用により分解してアルカ リ現像液中での溶解性を増大させる基を表す。X1~X 5は、同じでも異なってもよく、単結合、2価のアルキ レン基、シクロアルキレン基、-O-、-S-、又は-N (R₁₂) - R₁₃-基を表す。R₁₂は水素原子、アルキ ル基、単環あるいは多環のシクロアルキル基又はアルケ ニル基を表す。R13は単結合あるいは、エーテル基、エ ステル基、アミド基、ウレタン基、ウレイド基を有して も良い、2価のアルキレン基、シクロアルキレン基又は アルケニレン基を表す。l、m、nは、同じでも異なっ てもよく、0又は1~3の整数を示す。1、m、nが2 以上の場合は、各複数個のR4、R7、R10は同一でも 異なっても良い。

【請求項2】 (B)成分の樹脂が、請求項1に記載の一般式(I)、(II)又は(III)で表される繰り返し構造単位のうち少なくとも一つと、下記一般式(IV)、

(V) 又は(VI)で表される繰り返し構造単位のうち少なくとも一つを有し、酸の作用により分解してアルカリ現像液中での溶解性が増大する樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型感光性組成物。

【化2】

式 (IV) ~ (VI) 中、R₁₄、R₁₅、R₁₇~R₁₉は、同一 でも異なっても良く、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、アルキル基又はハロアルキル基を表す。R 16はシア ノ基、-CO-OR₂₀又は-CO-N(R₂₁)(R₂₂) を表す。X6~X8は、同一でも異なっても良く、単結 合、-O-、-SO2-、-O-CO-R23-、-CO -O-R₂₄-、-CO-N (R₂₅)-R₂₆-、置換基を 有していても良い、2価のアルキレン基、アルケニレン 基又はシクロアルキレン基を表す。R 20は、水素原子、 置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキ ル基もしくはアルケニル基、又は酸の作用により分解し てアルカリ現像液中での溶解性を増大させる基を表す。 R21、R22、R25は、同一でも異なっても良く、水素原 子、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロア ルキル基又はアルケニル基を表し、R 21と R 22が結合し て環を形成しても良い。R23、R24、R26は、同一でも 異なっても良く、単結合あるいは、エーテル基、エステ ル基、アミド基、ウレタン基、ウレイド基を有しても良 い、2価のアルキレン基、アルケニレン基又はシクロア ルキレン基を表す。Bは酸の作用により分解してアルカ リ現像液中での溶解性を増大させる基を表す。

【請求項3】 (B) 成分の樹脂が、更にカルボキシル基を有することを特徴とする請求項1又は2に記載のボジ型感光性組成物。

【請求項4】 (B) 成分の樹脂が、カルボキシル基を 有する一般式 (VII)、 (VIII) 又は (IX) で表される繰 50 り返し構造単位のうち少なくとも一つを有することを特

徴とする請求項3に記載のポジ型感光性組成物。 【化3】

式 (VII)~ (IX) 中、R 27、R 28、R 30~R 32は、同じ でも異なってもよく、水素原子、ハロゲン原子、シアノ 基、アルキル基又はハロアルキル基を表す。R 29はシア ノ基、-CO-OR33、-CO-N(R34)(R35)を 表す。X9~X11は、同じでも異なってもよく、単結 合、-O-、-SO2-、-O-CO-R36-、-CO -O-R37-、-CO-N (R38) -R39-、置換基を 有していても良い2価のアルキレン基、アルケニレン基 又はシクロアルキレン基を表す。R 33は水素原子、置換 基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基 又はアルケニル基を表す。R34、R35、R38は、同じで も異なってもよく、水素原子、置換基を有していても良 い、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を 表し、またR34とR35が結合して環を形成しても良い。 R36、R37、R39は、同じでも異なってもよく、単結合 あるいは、エーテル基、エステル基、アミド基、ウレタ ン基、ウレイド基を有しても良い、2価のアルキレン 基、アルケニレン基又はシクロアルキレン基を表す。

【請求項5】 酸の作用により分解し得る基を有し、アルカリ現像液中での溶解性が酸の作用により増大する、分子量3,000以下の低分子酸分解性溶解阻止化合物を含有することを特徴とする請求項1~4のいずれかに記載のポジ型感光性組成物。

【請求項6】 露光光源として、250 nm以下の波長の遠紫外光を使用することを特徴とする請求項1~5のいずれかに記載のポジ型感光性組成物。

【請求項7】 露光光源として、220 nm以下の波長の遠紫外光を使用することを特徴とする請求項6に記載のポジ型感光性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、IC等の半導体製造工程、液晶、サーマルヘッド等の回路基板の製造、更にその他のフォトファブリケーション工程に使用されるポジ型感光性組成物に関するものである。更に詳しくは250nm以下の波長の遠紫外線を露光光源とする場合に好適なポジ型感光性組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】ポジ型フォトレジスト組成物としては、 一般にアルカリ可溶性樹脂と感光物としてのナフトキノ ンジアジド化合物とを含む組成物が用いられている。例 4

えば、「ノボラック型フェノール樹脂/ナフトキノンジ アジド置換化合物」として米国特許第3,666,473号、米 国特許第4,115,128号及び米国特許第4,173,470号等に、 また最も典型的な組成物として「クレゾールーホルムア ルデヒドより成るノボラック樹脂/トリヒドロキシベン ゾフェノンー1、2ーナフトキノンジアジドスルホン酸 エステル」の例がトンプソン「イントロダクション・ト ゥー・マイクロリソグラフィー」 (L.F. Thompson 「Intr oduction to Microlithography」) (ACS出版、N o. 2. 19号、p112~121) に記載されてい る。このような基本的にノボラック樹脂とキノンジアジ ド化合物から成るポジ型フォトレジストは、ノボラック 樹脂がプラズマエッチングに対して高い耐性を与え、ナ フトキノンジアジド化合物は溶解阻止剤として作用す る。そして、ナフトキノンジアジドは光照射を受けると カルボン酸を生じることにより溶解阻止能を失い、ノボ ラック樹脂のアルカリ溶解度を高めるという特性を持

【0003】これまで、かかる観点からノボラック樹脂 20 とナフトキノンジアジド系感光物を含有する数多くのポジ型フォトレジストが開発、実用化され、0.8μm~2μm程度までの線幅加工に於いては十分な成果をおさめてきた。しかし、集積回路はその集積度を益々高めており、超LSIなどの半導体基板の製造に於いてはハーフミクロン以下の線幅から成る超微細パターンの加工が必要とされるようになってきた。

【0004】パターンの微細化を図る手段の一つとして、レジストのパターン形成の際に使用される露光光源の短波長化が知られている。このことは光学系の解像度(線幅) R を表すレイリーの式、

$R = k \cdot \lambda / N A$

30

(ここで λ は露光光源の波長、NAはレンズの開口数、k はプロセス定数)で説明することができる。この式からより高解像度を達成する、即ちRの値を小さくする為には、露光光源の波長 λ を短くすれば良いことがわかる。例えば 6.4 Mビットまでの集積度のDRAMの製造には、現在まで高圧水銀灯のi 線(3.6.5 nm)が光源として使用されてきた。2.5.6 MビットDRAMの量産プロセスには、i 線に変わり K r F エキシマレーザー

(248nm)が露光光源として採用が検討されている。更に1Gビット以上の集積度を持つDRAMの製造を目的として、より短波長の光源が検討されており、ArFエキシマレーザー(193nm)、F2エキシマレーザー(157nm)、X線、電子ビーム等の利用が有効であると考えられている(上野巧ら、「短波長フォトレジスト材料ーULSIに向けた微細加工ー」、ぶんしん出版、1988年)。

【0005】従来のノボラックとナフトキノンジアジド 化合物から成るレジストを遠紫外光やエキシマレーザー 50 光を用いたリングラフィーのパターン形成に用いると、

ノボラック及びナフトキノンジアジドの遠紫外領域に於ける吸収が強いために光がレジスト底部まで到達しにくくなり、低感度でテーパーのついたパターンしか得られない。

【0006】このような問題を解決する手段の一つが、 米国特許第4,491,628号、欧州特許第249,139号等に記載 されている化学増幅系レジスト組成物である。化学増幅 系ポジ型レジスト組成物は、遠紫外光などの放射線の照 射により露光部に酸を生成させ、この酸を触媒とする反 応によって、活性放射線の照射部と非照射部の現像液に 対する溶解性を変化させ、パターンを基板上に形成させ るパターン形成材料である。

【0007】このような例として、光分解により酸を発 生する化合物と、アセタールまたはO、N-アセタール 化合物との組合せ(特開昭48-89003号)、オル トエステル又はアミドアセタール化合物との組合せ(特 開昭51-120714号)、主鎖にアセタール又はケ タール基を有するポリマーとの組合せ(特開昭53-1 33429号)、エノールエーテル化合物との組合せ (特開昭55-12995号)、N-アシルイミノ炭酸 化合物化合物との組合せ(特開昭55-126236 号)、主鎖にオルトエステル基を有するポリマーとの組 合せ(特開昭56-17345号)、第3級アルキルエ ステル化合物との組合せ(特開昭60-3625号)、 シリルエステル化合物との組合せ(特開昭60-102 47号)、及びシリルエーテル化合物との組合せ(特開 昭60-37549号、特開昭60-121446号) 等を挙げることができる。これらは原理的に量子収率が 1を越えるため、高い感光性を示す。

【0008】同様に、酸存在下加熱することにより分解 し、アルカリ可溶化する系として、例えば、特開昭59 -45439号、特開昭60-3625号、特開昭62 -229242号、特開昭63-27829号、特開昭 63-36240号、特開昭63-250642号、特 開平5-181279号、Polym. Eng. Sce., 23巻、1012 頁(1983); ACS. Sym. 242巻、11頁(1984); Semicondu ctor World 1987年、11月号、91頁; Macromolecules, 21 巻、1475頁 (1988) ; SPIE, 920巻、42頁 (1988) 等に記 載されている露光により酸を発生する化合物と、第3級 又は2級炭素(例えばt-ブチル、2-シクロヘキセニル) のエステル又は炭酸エステル化合物との組合せ系、特開 平4-219757号、同5-249682号、同6-65332号等に記載されているアセタール化合物との 組み合わせ系、特開平4-211258号、同6-65 333号等に記載されている t ープチルエーテル化合物 との組み合わせ系等が挙げられる。

【0009】これらの系は、主として248nm領域での吸収の小さい、ポリ (ヒドロキシスチレン) を基本骨格とする樹脂を主成分に使用する為、KrFエキシマレーザーを露光光源とする場合には、高感度、高解像度

6

で、且つ良好なパターンを形成し、従来のナフトキノン ジアジド/ノボラック樹脂系に比べて良好な系となり得 る。しかしながら、更なる短波長の光源、例えばArF エキシマレーザー (193 nm) を露光光源として使用 する場合は、芳香族基を有する化合物が本質的に193 nm領域に大きな吸収を示す為、上記化学増幅系でも十 分ではなかった。また193nm領域の吸収の小さいポ リマーとして、ポリ (メタ) アクリレートの利用が]. V ac. Sci. Technol., B9, 3357 (1991). に記載されてい るが、このポリマーは一般に半導体製造工程で行われる ドライエッチングに対する耐性が、芳香族基を有する従 来のフェノール樹脂に比べ低いという問題があった。こ れに対し、脂環式基を有するポリマーが、芳香族基と同 様の耐ドライエッチング性を示し、且つ193nm領域 の吸収が小さいことがProc. of SPIE, 1672.66 (1992). で報告され、近年同ポリマーの利用が精力的に検討さ れるに至った。具体的には、特開平4-39665号、 同5-80515号、同5-265212号、同5-2 97591号、同5-346668号、同6-2896 15号、同6-324494号、同7-49568号、 同7-185046号、同7-191463号、同7-199467号、同7-234511号、同7-252 324号、同8-259626号等の明細書に記載され ているポリマーが挙げられる。

【0010】これらに示された脂環式基の内、特にアダマンチル基が最も良好な耐ドライエッチング性を有することは、Proc. of SPIE, 1672, 66 (1992)に示されており、該基を有するポリマーが特開平4-39665号、同7-199467号、同7-234511号、同8-259626号等の明細書に記載されている。しかしながら、これらポリマーは何れも(メタ)アクリレート系のポリマーであり、耐ドライエッチング性が必ずしも十分とは言えなかった。また画像形成に必要な酸分解性モノマー、基板密着性に必要な親水性(極性)モノマーと共重合する場合、アダマンチル基を有する疎水性モノマーとの共重合性(各モノマー成分の均一なポリマー鎖への導入)を図るのが困難であった。その結果、不均一な重合により樹脂の溶剤溶解性が低下したり、合成の再現性に問題が生じることがあった。

0 [0011]

【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的は、250 nm以下、特に220 nm以下の波長の露光光源の使用に好適なポジ型感光性組成物を提供することであり、具体的には250 nm以下、特に220 nm以下の波長の露光光源の使用時に、良好な感度、解像度を与え、更に十分な耐ドライエッチング性を有し、且つ溶剤溶解性が良好なポジ型感光性組成物を提供することである。

[0012]

🛚 【課題を解決するための手段】本発明者等は、上記賭特

性に留意し鋭意検討した結果、本発明の目的が以下の特 定の脂環基を有する繰り返し構造単位と酸分解性基を有 する樹脂を使用することで見事に達成されることを見出 し、本発明に到達した。即ち、本発明は下記構成であ る。

(1) (A) 活性光線又は放射線の照射により酸を発 生する化合物、及び(B)下記一般式(I)、(II)又 * *は(III) で表されるアダマンチル基を有する繰り返し構 造単位の少なくとも一つと、酸の作用により分解してア ルカリ現像液中での溶解性を増大させる基の少なくとも 一つを有する樹脂を含有することを特徴とするポジ型感 光性組成物。

[0013] 【化4】

30

【0014】式(I)~(III)中、R1、R2、R5、 R8、R9は、同じでも異なってもよく、水素原子、ハ ロゲン原子、シアノ基、アルキル基又はハロアルキル基 を表す。R4、R7、R10は、同じでも異なってもよ く、ハロゲン原子、シアノ基、置換基を有していても良 い、アルキル基、アルケニル基もしくはアルキニル基、 又は-CO-O-R11基を表す。R3、R6、R11は、 同じでも異なってもよく、水素原子、置換基を有してい ても良い、アルキル基、単環あるいは多環のシクロアル キル基もしくはアルケニル基、又は酸の作用により分解 してアルカリ現像液中での溶解性を増大させる基を表 す。 X1~ X5 は、同じでも異なってもよく、単結合、 2価のアルキレン基、シクロアルキレン基、-O-、-S-、又は-N(R₁₂)-R₁₃-基を表す。R₁₂は水素 原子、アルキル基、単環あるいは多環のシクロアルキル 基又はアルケニル基を表す。R 13は単結合あるいは、エ ーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基、ウレイ ド基を有しても良い、2価のアルキレン基、シクロアル キレン基又はアルケニレン基を表す。l、m、nは、同 じでも異なってもよく、0又は1~3の整数を示す。 l、m、nが2以上の場合は、各複数個のR4、R1、 R10は同一でも異なっても良い。

(B) 成分の樹脂が、上記(1) [0015](2)に記載の一般式 (I)、 (II) 又は(III) で表される繰 り返し構造単位のうち少なくとも一つと、下記一般式 (IV)、(V)又は(VI)で表される繰り返し構造単位 のうち少なくとも一つを有し、酸の作用により分解して アルカリ現像液中での溶解性が増大する樹脂であること を特徴とする上記(1)に記載のポジ型感光性組成物。

[0016]

【化5】

【0017】式 (IV) ~ (VI) 中、R 14、R 15、R 17~ R19は、同一でも異なっても良く、水素原子、ハロゲン 原子、シアノ基、アルキル基又はハロアルキル基を表 す。R16はシアノ基、-CO-OR20又は-CO-N (R₂₁) (R₂₂) を表す。X₆~X₈は、同一でも異な っても良く、単結合、-O-、-SO2-、-O-CO $-R_{23}-$, $-CO-O-R_{24}-$, -CO-N (R₂₅) -R26-、置換基を有していても良い、2価のアルキレン 基、アルケニレン基又はシクロアルキレン基を表す。R 20は、水素原子、置換基を有していても良い、アルキル 基、シクロアルキル基もしくはアルケニル基、又は酸の 作用により分解してアルカリ現像液中での溶解性を増大 させる基を表す。 R 21、 R 22、 R 25は、同一でも異なっ ても良く、水素原子、置換基を有していても良い、アル 40 キル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表し、R 21と R 22が結合して環を形成しても良い。 R 23、 R 24、 R26は、同一でも異なっても良く、単結合あるいは、エ ーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基、ウレイ ド基を有しても良い、2価のアルキレン基、アルケニレ ン基又はシクロアルキレン基を表す。Bは酸の作用によ り分解してアルカリ現像液中での溶解性を増大させる基 を表す。

【0018】(3) (B) 成分の樹脂が、更にカルボ キシル基を有することを特徴とする上記(1)又は

(2) に記載のポジ型感光性組成物。

(4) (B) 成分の樹脂が、カルボキシル基を有する一般式 (VII)、 (VIII) 又は (IX) で表される繰り返し構造単位のうち少なくとも一つを有することを特徴とする前記 (3) に記載のポジ型感光性組成物。

[0019]

[116]

【0020】式 (VII)~ (IX) 中、R 27、R 28、R 30~ R32は、同じでも異なってもよく、水素原子、ハロゲン 原子、シアノ基、アルキル基又はハロアルキル基を表 す。R29はシアノ基、-CO-OR33、-CO-N(R 34) (R35) を表す。 X9 ~ X11は、同じでも異なって もよく、単結合、-O-、-SO2-、-O-CO-R 36-, -CO-O-R37-, -CO-N(R38)-R39一、置換基を有していても良い2価のアルキレン基、ア ルケニレン基又はシクロアルキレン基を表す。R 33は水 素原子、置換基を有していても良い、アルキル基、シク ロアルキル基又はアルケニル基を表す。R34、R35、R 38は、同じでも異なってもよく、水素原子、置換基を有 していても良い、アルキル基、シクロアルキル基又はア ルケニル基を表し、またR34とR35が結合して環を形成 しても良い。 R 36、 R 37、 R 39は、同じでも異なっても よく、単結合あるいは、エーテル基、エステル基、アミ ド基、ウレタン基、ウレイド基を有しても良い、2価の アルキレン基、アルケニレン基又はシクロアルキレン基 を表す。

【0021】(5) 酸の作用により分解し得る基を有し、アルカリ現像液中での溶解性が酸の作用により増大する、分子量3,000以下の低分子酸分解性溶解阻止化合物を含有することを特徴とする上記(1)~(4)のいずれかに記載のポジ型感光性組成物。

(6) 露光光源として、250nm以下の波長の遠紫外光を使用することを特徴とする上記(1)~(5)のいずれかに記載のポジ型感光性組成物。

(7) 露光光源として、220 n m以下の波長の遠紫外光を使用することを特徴とする上記(6)に記載のポジ型感光性組成物。

[0022]

【発明の実施の形態】以下、本発明に使用する化合物について詳細に説明する。本発明における(B)成分の樹脂にていて説明する。

[1]一般式(I)~(III) で示される繰り返し構造単位

前記一般式におけるR₁、R₂、R₅、R₈、R₉のア

10

ルキル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチル基、エチル基、プロビル基、 nーブチル基、 secーブチル基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。ハロアルキル基としては、好ましくはフッ素原子、塩素原子、臭素原子が置換した炭素数1~4個のアルキル基、例えばフルオロメチル基、クロロメチル基、プロモメチル基、フルオロエチル基、クロロエチル基、プロモエチル基等が挙げられる。

【0023】R4、R7、R10のアルキル基としては、 好ましくは置換基を有していても良い、メチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、secープチル基、 ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オクチル基のような炭素数1~8個のものが挙げられる。アルケニル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、ビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基の様な炭素数2~6個のものが挙げられる。アルキニル基としては、好ましくはアセチル基、プロバルギル基の様な炭素数2~4個のものが挙げられる。

【0024】R3、R6、R11、R12のアルキル基、アルケニル基としては、上記R4、R7、R10で示したものと同様のものが好ましい。単環あるいは多環型のシクロアルキル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、シクロプロビル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基のような炭素数3~8個の単環型や、アダマンチル基、ノルボルニル基、イソボロニル基、ジシクロペンチル基、σービネル基、トリシクロデカニル基等の多環型のものが挙げられる。

【0025】X1~X5のアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチレン基、エチレン基、プラピレン基、プチレン基、ヘキシレン基、カクテレン基等の炭素数1~8個のものが挙げられる。シクロアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、シクロペンチレン基、シクロヘキシレン基の炭素数5~8個のものが挙げられる。R13のアルキレン基、シクロアルキレン基としては、上記X1~X5で示したものと同様のものが挙げられる。アルケニレン基としては、エテニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基としては、エテニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基等の炭素数2~6個のものが挙げられる。これらの2個の基(アルキレン基、シクロアルキレン基、アルケニレン基)は、更にエーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基、ウレイド基の少なくとも1つと一緒になって形成した2価の基も挙げることができる。

【0026】R3、R6、R11は、酸の作用により分解してアルカリ現像液中での溶解性を増大させる基(酸分解性基ともいう)を表す。酸分解性基としては、例えば、酸の作用により加水分解し酸を形成する基、更には酸の作用により炭素カチオンが脱離し酸を形成する基が挙げられる。好ましくは下記一般式(X)又は(XI)で50表される基である。

[0 0 2 7]
[
$$1$$
th 7]

 Z_1
 R_{40}
 $-C$
 Z_2
 C
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}
 R_{41}

【0028】式(X)、(XI)中のR40~R42は、それぞれ同一でも相異していても良く、水素原子もしくは、置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基、又はアルケニル基を表す。但し、式(X)のR40~R42の内、少なくとも1つは水素原子以外の基である。R43は置換基を有していても良い、アルキル基、シクロアルキル基又はアルケニル基を表す。また式(X)のR40~R42の内の2つ、及び式(XI)のR40、R41、R43の内の2つの基が結合して3~8個の炭素原子、ヘテロ原子から成る環構造を形成しても良い。このような環としては具体的には、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、シクロヘプチル基、1~シクロヘキセニル基、2~テトラヒドロフラニル基、2~テトラヒドロピラニル基等が挙げられる。21、2

12

2 は、O又はSを表す。ここでアルキル基、シクロアルキル基、アルケニル基としては、上記R3、R6、R11、R12で示したものと同様のものが好ましい。 【0029】1、m、nは0又は1~3の整数を示すが、好ましくは0又は1~2の整数を示す。

【0030】また上記置換基における更なる置換基としては、好ましくは、水酸基、ハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ基、アミド基、スルホンアミド基、上記R3、R6、R11、R12のアル10 キル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~8個のアルコキシ基、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ホルミル基、アセチル基、ベンゾイル基等のアシル基、アセトキシ基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、カルボキシ基が挙げられる。

【0031】以下に一般式(I)~(III)で表される繰り返し構造単位の具体例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

20 【0032】 【化8】

[0033]

[0034]

[0035]

į

[0036]

【化12】

【0037】 【化13】 30

【0038】 【化14】

24

【0039】本発明の樹脂中における上記脂環式基を有する一般式(I)~(III)で表される繰り返し構造単位の含有量は、耐ドライエッチング性、アルカリ現像性等とのバランスにより調整されるが、全繰り返し単位に対して20モル%以上含有することが好ましい。より好ましくは30~100モル%、更に好ましくは40~90モル%、特に好ましくは45~75モル%の範囲である

【0040】[2]酸分解性基を有する繰り返し構造単位

本発明に係わる樹脂において、酸分解性基は一般式 (I) ~一般式(III) で示される繰り返し構造単位中 $(R_3 \ R_6 \ R_{II})$ に含まれてもよいし、更にその他 の繰り返し構造単位中に含まれてもよいし、それら両方に含まれてもよい。酸分解性基を有する繰り返し構造単位としては、一般式(IV)~(VI)で表される繰り返し

構造単位が好ましい。

【0041】前記一般式 (IV) ~ (VI) におけるR 14、 40 R 15、R 17~R 19のアルキル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチル基、エチル基、プロピル基、nープチル基、secープチル基のような炭素数 1~4個のものが挙げられる。ハロアルキル基としては、好ましくはフッ素原子、塩素原子、臭素原子が置換した炭素数1~4個のアルキル基、例えばフルオロメチル基、クロロメチル基、ブロモメチル基、フルオロエチル基、クロロエチル基、ブロモエチル基等が挙げられる。R 20~R 22、R 25のアルキル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチル基、エチル基、プ 50

ロビル基、nープチル基、secープチル基、ヘキシル基、2-エチルヘキシル基、オクチル基のような炭素数1~8個のものが挙げられる。シクロアルキル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、シクロプロビル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基のような炭素数3~8個のものが挙げられる。アルケニル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、ビニル基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基の様な炭素数2~6個のものが挙げられる。R21とR22とが互いに結合して窒素原子とともに形成する環としては、5~8員環が好ましく、具体的にはビロリジン、ピペリジン、ピペラジン等が挙げられる。

【0042】X6~X8、R23、R24、R26のアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、 ペキシレン基、オクチレン基等の炭素数1~8個のものが挙げられる。アルケニレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、エテニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基等の炭素数2~6個のものが挙げられる。シクロアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、シクロペンチレン基、シクロへよりレン基等の炭素数5~8個のものが挙げられる。R23、R24、R26は、更に上記アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基と、エーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基、ウレイド基の少なくとも1つとが一緒になって2価の基を構成してもよい。

○ 【0043】また上記置換基の更なる置換基としては、

好ましくは水酸基、ハロゲン原子(フッ素、塩素、臭 素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ基、アミド基、スルホ ンアミド基、R20~R22、R25のアルキル基、メトキシ 基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ 基、ヒドロキシプロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1 ~8個のアルコキシ基、メトキシカルポニル基、エトキ シカルボニル基等のアルコキシカルボニル基、ホルミル 基、アセチル基、ベンゾイル基等のアシル基、アセトキ シ基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、カルボキシ 基が挙げられる。

【0044】B、R20は酸の作用により分解してアルカ

*リ現像液中での溶解性を増大させる基を表す。酸分解性 基としては、例えば、酸の作用により加水分解し酸を形 成する基、更には酸の作用により炭素カチオンが脱離し 酸を形成する基が挙げられる。好ましくは上記R3、R 6、R₁₁のところで示した一般式(X)又は(XI)で表 される基である。

28

【0045】以下に一般式 (IV) ~ (VI) で表される繰 り返し構造単位の具体例を示すが、本発明がこれに限定 されるものではない。

[0046] 【化15】

[0047]

(

30

(b12) (b15) (b13) (b16) *【化17】 O=CH-OC2H4-CI O-CH2-OC2H4-OCH3 (b20) (b19) O-CH-OCH2CH2-O-COCH3 (b22) (b21)

(b23)

(b24)

【0049】 【化18】

[0048]

【0050】本発明の樹脂中における酸分解性基を含有する繰り返し構造単位(好ましくは上記一般式(IV)~(VI)で表される繰り返し構造単位)の含有量は、アルカリ現像性、基板密着性、更には耐ドライエッチング性等の性能により調整されるが、好ましくは0~50モル%、更に好ましくは5~40モル%、また更に好ましくは10~30モル%の範囲で使用される。ここで、酸分解性基を含有する繰り返し構造単位の含有量は、酸分解性基を含有する一般式(I)~(III)で示される繰り返し構造単位の量も含めた、本発明の樹脂中の全ての酸分解性基を含有する繰り返し構造単位の含有量である。

(b29)

(b30)

【0051】 [3] カルボキシル基を有する繰り返し構造単位

本発明に係わる樹脂において、カルボキシル基は、上記一般式(I)~(III)で示される繰り返し構造単位中に含まれてもよいし、酸分解性基を有する繰り返し構造単位中に含まれてもよいし、それらとは別の繰り返し構造単位中に含まれてもよい。更にこれらのカルボキシル基の置換場所のうち複数の場所に含まれてもよい。カルボキシル基を有する繰り返し構造単位としては、上記一般式(VII)~(IX)で表される繰り返し構造単位が好ましい。

【0052】前記一般式 (VII) ~ (IX) におけるR 27、R 28、R 30~R 32のアルキル基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチル基、エチル基、プロピル基、nーブチル基、secーブチル基のような炭素数1~4個のものが挙げられる。ハロアルキル基としては、好ましくはフッ素原子、塩素原子、臭素原子が置換

32

した炭素数1~4個のアルキル基、例えばフルオロメチ ル基、クロロメチル基、プロモメチル基、フルオロエチ ル基、クロロエチル基、プロモエチル基等が挙げられ る。R34、R35、R38のアルキル基としては、好ましく は置換基を有していても良い、メチル基、エチル基、プ ロピル基、nープチル基、secーブチル基、ヘキシル 基、2-エチルヘキシル基、オクチル基のような炭素数 1~8個のものが挙げられる。シクロアルキル基として は、好ましくは置換基を有していても良い、シクロプロ 10 ピル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基のような 炭素数3~8個のものが挙げられる。アルケニル基とし ては、好ましくは置換基を有していても良い、ビニル 基、プロペニル基、アリル基、ブテニル基、ペンテニル 基、ヘキセニル基、シクロヘキセニル基の様な炭素数2 ~6個のものが挙げられる。R34とR35とが互いに結合 して窒素原子とともに形成する環としては、5~8員環 が好ましく、具体的にはピロリジン、ピペリジン、ピペ ラジン等が挙げられる。

【0053】X9~X11、R36、R37、R39のアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、メチレン基、エチレン基、プロピレン基、プチレン基、ヘキシレン基、オクチレン基等の炭素数1~8個のものが挙げられる。アルケニレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、エテニレン基、プロペニレン基、ブテニレン基等の炭素数2~6個のものが挙げられる。シクロアルキレン基としては、好ましくは置換基を有していても良い、シクロペンチレン基、シクロへキシレン基等の炭素数5~8個のものが挙げられる。R36、R37、R39は、更に上記アルキレン基、アルケニレン基、シクロアルキレン基と、エーテル基、エステル基、アミド基、ウレタン基、ウレイド基の少なくとも1つとが一緒になって2価の基を構成してもよい。

【0054】また上記置換基における更なる置換基としては、好ましくは水酸基、ハロゲン原子(フッ素、塩素、臭素、ヨウ素)、ニトロ基、シアノ基、アミド基、スルホンアミド基、R34、R35、R38のアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、ヒドロキシエトキシ基、プロポキシ基、ヒドロキシプロポキシ基、ブトキシ基等の炭素数1~8個のアルコキシ基、メトキシカルボニル基、エルミル基、アセチル基、ベンゾイル基等のアシル基、アセトキシ基、ブチリルオキシ基等のアシロキシ基、カルボキシ基が挙げられる。

【0055】以下に一般式(VII)~(IX)で表される繰り返し構造単位の具体例を示すが、本発明がこれに限定されるものではない。

[0056]

【化19】

【0058】本発明の樹脂中におけるカルボキシル基を有する繰り返し構造単位(好ましくは上記一般式(VII)~(IX)で表される繰り返し構造単位)の含有量は、アルカリ現像性、基板密着性、更には感度等の性能により調整されるが、全繰り返し構造単位に対して好ましくは0~60モル%、より好ましくは0~40モル%、特に好ましくは0~20モル%の範囲で使用される。ここで、このカルボキシル基含有繰り返し構造単位の含有量は、カルボキシル基を含有する上記一般式(I)~(III)で示される繰り返し構造単位及びカルボキシル基を含有する酸分解性基含有繰り返し構造単位も含めた、樹脂中の全てのカルボキシル基含有繰り返し構造単位の量である。

0 【0059】 [4] 前記繰り返し構造単位を有する本発明の成分(B)の樹脂また本発明の成分(B)の樹脂の性能を向上させる目的で、同樹脂の220nm以下の透過性及び耐ドライエッチング性を著しく損なわない範囲で、更に他の重合性モノマーを共重合させても良い。使用することができる共重合モノマーとしては、以下に示すものが含まれる。例えば、アクリル酸エステル類、アクリルアミド類、メタクリル酸エステル類、メタクリルアミド類、アリル化合物、ビニルエーテル類、ビニルエステル類、スチレン

50 類、クロトン酸エステル類などから選ばれる付加重合性

不飽和結合を1個有する化合物である。

【0060】具体的には、例えばアクリル酸エステル 類、例えばアルキル (アルキル基の炭素原子数は1~1 0のものが好ましい)アクリレート (例えば、アクリル 酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸プロピル、ア クリル酸tーブチル、アクリル酸アミル、アクリル酸シ クロヘキシル、アクリル酸エチルヘキシル、アクリル酸 オクチル、アクリル酸ーtーオクチル、クロルエチルア クリレート、2-ヒドロキシエチルアクリレート2、2 -ジメチルヒドロキシプロピルアクリレート、5-ヒド ロキシペンチルアクリレート、トリメチロールプロパン モノアクリレート、ペンタエリスリトールモノアクリレ ート、グリシジルアクリレート、ベンジルアクリレー ト、メトキシベンジルアクリレート、フルフリルアクリ レート、テトラヒドロフルフリルアクリレート、など) アリールアクリレート(例えばフェニルアクリレート、 ヒドロキシフェニルアクリレートなど):

【0061】メタクリル酸エステル類、例えば、アルキ ル(アルキル基の炭素原子数は1~10のものが好まし い)メタクリレート(例えば、メチルメタクリレート、 エチルメタクリレート、プロピルメタクリレート、イソ プロピルメタクリレート、t-ブチルメタクリレート、 アミルメタクリレート、ヘキシルメタクリレート、シク ロヘキシルメタクリレート、ベンジルメタクリレート、 クロルベンジルメタクリレート、オクチルメタクリレー ト、2-ヒドロキシエチルメタクリレート、4-ヒドロ キシブチルメタクリレート、5-ヒドロキシペンチルメ タクリレート、2、2-ジメチル-3-ヒドロキシプロ ピルメタクリレート、トリメチロールプロパンモノメタ クリレート、ペンタエリスリトールモノメタクリレー ト、グリシジルメタクリレート、フルフリルメタクリレ ート、テトラヒドロフルフリルメタクリレートなど)、 アリールメタクリレート(例えば、フェニルメタクリレ ート、ヒドロキシフェニルメタクリレート、クレジルメ タクリレート、ナフチルメタクリレートなど);アクリ ルアミド類、例えば、アクリルアミド、N-アルキルア クリルアミド、 (アルキル基としては、炭素原子数1~ 10のもの、例えば、メチル基、エチル基、プロピル 基、ブチル基、tーブチル基、ヘプチル基、オクチル 基、シクロヘキシル基、ベンジル基、ヒドロキシエチル 基、ベンジル基などがある。)、N-アリールアクリル アミド(アリール基としては、例えばフェニル基、トリ ル基、ニトロフェニル基、ナフチル基、シアノフェニル 基、ヒドロキシフェニル基、カルボキシフェニル基など がある。)、N、Nージアルキルアクリルアミド(アル キル基としては、炭素原子数1~10のもの、例えば、 メチル基、エチル基、ブチル基、イソブチル基、エチル ヘキシル基、シクロヘキシル基などがある。)、N, N - アリールアクリルアミド (アリール基としては、例え ばフェニル基などがある。)、N-メチル-N-フェニ 36

ルアクリルアミド、N-ヒドロキシエチル-N-メチル アクリルアミド、N-2-アセトアミドエチル-N-ア セチルアクリルアミドなど;メタクリルアミド類、例え ば、メタクリルアミド、N-アルキルメタクリルアミド (アルキル基としては、炭素原子数1~10のもの、例 えば、メチル基、エチル基、t-ブチル基、エチルヘキ シル基、ヒドロキシエチル基、シクロヘキシル基などが ある。)、N-アリールメタクリルアミド(アリール基 としては、フェニル基、ヒドロキシフェニル基、カルボ 10 キシフェニル基などがある。)、N, N-ジアルキルメ タクリルアミド (アルキル基としては、エチル基、プロ ピル基、ブチル基などがある。)、N, N-ジアリール メタクリルアミド(アリール基としては、フェニル基な どがある。)、N-ヒドロキシエチル-N-メチルメタ クリルアミド、NーメチルーNーフェニルメタクリルア ミド、N-エチルーN-フェニルメタクリルアミドな ど;アリル化合物、例えば、アリルエステル類 (例え ば、酢酸アリル、カプロン酸アリル、カプリル酸アリ ル、ラウリン酸アリル、パルミチン酸アリル、ステアリ 20 ン酸アリル、安息香酸アリル、アセト酢酸アリル、乳酸 アリルなど)、アリルオキシエタノールなど;

【0062】ビニルエーテル類、例えば、アルキルビニ ルエーテル(例えば、ヘキシルビニルエーテル、オクチ ルビニルエーテル、デシルビニルエーテル、エチルヘキ シルビニルエーテル、メトキシエチルビニルエーテル、 エトキシエチルビニルエーテル、クロルエチルビニルエ ーテル、1-メチル-2, 2-ジメチルプロピルビニル エーテル、2-エチルブチルビニルエーテル、ヒドロキ シエチルビニルエーテル、ジエチレングリコールビニル エーテル、ジメチルアミノエチルビニルエーテル、ジエ チルアミノエチルビニルエーテル、ブチルアミノエチル ビニルエーテル、ベンジルビニルエーテル、テトラヒド ロフルフリルビニルエーテルなど)、ビニルアリールエ ーテル(例えばビニルフェニルエーテル、ビニルトリル エーテル、ビニルクロルフェニルエーテル、ビニルー 2, 4-ジクロルフェニルエーテル、ビニルナフチルエ ーテル、ビニルアントラニルエーテルなど);ビニルエ ステル類、例えば、ビニルブチレート、ビニルイソブチ レート、ビニルトリメチルアセテート、ビニルジエチル 40 アセテート、ビニルバレート、ビニルカプロエート、ビ ニルクロルアセテート、ビニルジクロルアセテート、ビ ニルメトキシアセテート、ビニルブトキシアセテート、 ビニルフェニルアセテート、ビニルアセトアセテート、 ビニルラクテート、ビニルー 8-フェニルブチレート、 ビニルシクロヘキシルカルボキシレート、安息香酸ビニ ル、サルチル酸ビニル、クロル安息香酸ビニル、テトラ クロル安息香酸ビニル、ナフトエ酸ビニルなど;

【0063】スチレン類、例えば、スチレン、アルキルスチレン(例えば、メチルスチレン、ジメチルスチレ 50 ン、トリメチルスチレン、エチルスチレン、ジエチルス

チレン、イソプロピルスチレン、ブチルスチレン、ヘキ シルスチレン、シクロヘキシルスチレン、デシルスチレ ン、ベンジルスチレン、クロルメチルスチレン、トリフ ルオルメチルスチレン、エトキシメチルスチレン、アセ トキシメチルスチレンなど)、アルコキシスチレン(例 えば、メトキシスチレン、4-メトキシー3-メチルス チレン、ジメトキシスチレンなど)、ハロゲンスチレン (例えば、クロルスチレン、ジクロルスチレン、トリク ロルスチレン、テトラクロルスチレン、ペンタクロルス チレン、プロムスチレン、ジプロムスチレン、ヨードス チレン、フルオルスチレン、トリフルオルスチレン、2 ープロムー4ートリフルオルメチルスチレン、4ーフル オルー3ートリフルオルメチルスチレンなど)、ヒドロ キシスチレン (例えば、4-ヒドロキシスチレン、3-ヒドロキシスチレン、2-ヒドロキシスチレン、4-ヒ ドロキシー3ーメチルスチレン、4ーヒドロキシー3, 5-ジメチルスチレン、4-ヒドロキシー3-メトキシ スチレン、4ーヒドロキシー3ー(2ーヒドロキシベン ジル) スチレンなど)、カルボキシスチレン;クロトン 酸エステル類、例えば、クロトン酸アルキル(例えば、 クロトン酸プチル、クロトン酸ヘキシル、グリセリンモ ノクロトネートなど);イタコン酸ジアルキル類(例え ば、イタコン酸ジメチル、イタコン酸ジエチル、イタコ ン酸ジブチルなど);マレイン酸あるいはフマール酸の ジアルキルエステル類(例えば、ジメチルマレレート、 ジブチルフマレートなど)、無水マレイン酸、マレイミ ド、アクリロニトリル、メタクリロニトリル、マレイロ ニトリル等がある。その他、一般的には共重合可能であ る付加重合性不飽和化合物であればよい。

【0064】この中で、カルボキシスチレン、N-(カルボキシフェニル)アクリルアミド、N-(カルボキシフェニル)アクリルアミド等のようなカルボキシル基を有するモノマー、ヒドロキシスチレン、N-(ヒドロキシフェニル)アクリルアミド、N-(ヒドロキシフェニルアクリレート、ヒドロキシフェニルメタクリレート等のフェノール性水酸基を有するモノマー、マレイミド等、アルカリ溶解性を向上させるモノマーが共重合成分として好ましい。本発明における樹脂中の他の重合性モノマーの含有量としては、全繰り返し単位に対して、50モル%以下が好ましく、より好ましくは30モル%以下である。

【0065】一般式(I)~(III)で示される繰り返し構造単位(一般式(IV)~(VI)で表される各繰り返し構造単位、及び一般式(VII)~(IX)で表される各繰り返し構造単位を含有するものも含む)を含有する本発明の成分(B)の樹脂は、各構造に対応する不飽和モノマーのラジカル、カチオン、又はアニオン重合により合成される。更に詳しくは前記に示した好ましい組成に基づき各モノマーを配合し、適当な溶媒中、約10~40重量%のモノマー濃度にて重合触媒を添加し、必要に応じ

加温して重合される。

【0066】本発明の成分(B)の樹脂の分子量は、重量平均(Mw:ポリスチレン標準)で2,000以上、好ましくは3,000~1,000,000、より好ましくは5,000~200,000、更に好ましくは20,000~100,000 の範囲であり、大きい程、耐熱性等が向上する一方で、現像性等が低下し、これらのバランスにより好ましい範囲に調整される。また分散度(Mw/Mn)は、好ましくは1.0~5.0、より好ましくは1.0~3.0であり、小さい程、耐熱性、画像性能(パターンプロファイル、デフォーカスラチチュード等)が良好となる。

【0067】本発明において、上記樹脂の感光性組成物中の添加量としては、全固形分に対して50~99.7 重量%、好ましくは70~99重量%である。

【0068】 [5] 本発明の成分(A) の光酸発生剤 本発明で用いられる光酸発生剤は、活性光線又は放射線 の照射により酸を発生する化合物である。本発明で使用 される活性光線または放射線の照射により分解して酸を 発生する化合物としては、光カチオン重合の光開始剤、 光ラジカル重合の光開始剤、色素類の光消色剤、光変色 剤、あるいはマイクロレジスト等に使用されている公知 の光 (400~200 n m の紫外線、遠紫外線、特に好 ましくは、g線、h線、i線、KrFエキシマレーザー 光)、ArFエキシマレーザー光、電子線、X線、分子 線又はイオンビームにより酸を発生する化合物およびそ れらの混合物を適宜に選択して使用することができる。 【0069】また、その他の本発明に用いられる活性光 線又は放射線の照射により酸を発生する化合物として は、たとえば S. I. Schlesinger, Photogr. Sci. Eng., 18,3 87(1974)、T.S. Bal etal, Polymer, 21, 423(1980)等に記 載のジアゾニウム塩、米国特許第4,069,055号、同4,06 9,056号、同 Re 27,992号、特願平3-140,140号等に記載 のアンモニウム塩、D.C. Necker etal, Macromolecules, 1 7, 2468(1984), C.S. Wenetal, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing ASIA, p478 Tokyo, Oct (1988)、米国特許第4,069,055 号、同4,069,056号等に記載のホスホニウム塩、J.V.Cri vello etal, Macromorecules, 10(6), 1307(1977), Chem. &Eng. News, Nov. 28, p31(1988)、欧州特許第104, 143 号、 米国特許第339,049号、同第410,201号、特開平2-150,84 8号、特開平2-296,514 号等に記載のヨードニウム塩、 J. V. Crivello etal, Polymer J. 17, 73 (1985), J. V. Crive llo etal. J. Org. Chem., 43, 3055 (1978), W. R. Watt eta 1, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 22, 1789 (1984). J. V. Crivello etal, Polymer Bull., 14, 279 (1985), J. V. Crivello etal, Macromorecules, 14(5), 1141(1981), J. V. Crivello etal, J. PolymerSci., Polymer Chem. Ed., 17, 2877(1979) 、欧州特許第370,693 号、同3,902,114号同 233,567号、同297,443号、同297,442号、米国特許第4,9 33,377号、同161,811号、同410,201号、同339,049号、

同4.760,013号、同4,734,444号、同2,833,827号、獨国 特許第2,904,626号、同3,604,580号、同3,604,581号、 特開平7-28237号、同8-27102号等に記載 のスルホニウム塩、J.V. Crivello etal, Macromorecule s. 10(6), 1307(1977), J. V. Crivello et al, J. Polymer Sc i., Polymer Chem. Ed., 17, 1047(1979)等に記載のセレノ ニウム塩、C.S.Wen etal, Teh, Proc. Conf. Rad. Curing AS IA, p478 Tokyo, Oct (1988) 等に記載のアルソニウム塩等 のオニウム塩、米国特許第3,905,815号、特公昭46-4605 号、特開昭48-36281号、特開昭55-32070号、特開昭60-2 39736号、特開昭61-169835号、特開昭61-169837号、特 開昭62-58241号、特開昭62-212401号、特開昭63-70243 号、特開昭63-298339号等に記載の有機ハロゲン化合 物、K. Meier et al, J. Rad. Curing, 13(4), 26(1986) 、T. P. Gill et al. Inorg. Chem., 19, 3007 (1980), D. Astruc, A cc. Chem. Res., 19(12), 377(1896)、特開平2-161445号等 に記載の有機金属/有機ハロゲン化物、S. Hayase eta 1, J. Polymer Sci., 25, 753(1987), E. Reichmanis et al, J. Pholymer Sci., Polymer Chem. Ed., 23, 1(1985), Q. Q. Zhu etal, J. Photochem., 36, 85, 39, 317(1987), B. Amit etal, Tetrahedron Lett., (24) 2205 (1973), D. H. R. Barton eta 1, J. Chem Soc., 3571 (1965), P. M. Collins et al, J. Chem. SoC., PerkinI, 1695 (1975) M. Rudinstein etal, Tetrahed ron Lett., (17), 1445 (1975) J. W. Walker et al J. Am. Che m. Soc., 110, 7170(1988), S. C. Busman et al., J. Imaging Te chnol., 11(4), 191(1985), H. M. Houlihan etal, Macormole cules, 21, 2001 (1988), P.M. Collins et al, J. Chem. Soc., Chem. Commun., 532 (1972), S. Hayase et al, Macromolecule s, 18, 1799 (1985), E. Reichmanis et al, J. Electrochem. So c., Solid State Sci. Technol., 130(6), F. M. Houlihan et al, Macromolcules, 21, 2001 (1988)、欧州特許第0290, 750 号、同046,083号、同156,535号、同271,851号、同0,38 8,343号、米国特許第3,901,710号、同4,181,531号、特 開昭60-198538号、特開昭53-133022号等に記載の0-ニ トロベンジル型保護基を有する光酸発生剤、M. TUNOOKA etal, Polymer Preprints Japan, 35(8), G. Berner etal, J. Rad. Curing, 13(4), W. J. Mijs etal, Coating Techno 1.,55(697),45(1983), Akzo, H. Adachi etal, Polymer Pr eprints, Japan, 37(3)、欧州特許第0199, 672号、同84515 号、同199,672号、同044,115号、同0101,122号、米国特 許第618,564号、同4,371,605号、同4,431,774 号、特開 昭64-18143号、特開平2-245756号、特願平3-140109号等 に記載のイミノスルフォネート等に代表される光分解し てスルホン酸を発生する化合物、特開昭61-166544号、 特開平2-71270号等に記載のジスルホン化合物、 特開平3-103854号、同3-103856号、同 4-210960号等に記載のジアゾケトスルホン、ジ アゾジスルホン化合物を挙げることができる。

【0070】また、これらの光により酸を発生する基、あるいは化合物をポリマーの主鎖または 側鎖に導入し

40

た化合物、たとえば、M.E. Woodhouse etal, J. Am. Chem. Soc., 104,5586(1982)、S. P. Pappas etal, J. Imaging Sci., 30(5),218(1986)、S. Kondoetal, Makromol. Chem., Rapid Commun., 9,625(1988)、Y. Yamadaetal, Makromol. Chem., 152,153,163(1972)、J. V. Crivello etal, J. Polymer Sci., Polymer Chem. Ed., 17,3845(1979)、米国特許第3,849,137号、獨国特許第3914407、特開昭63-26653号、特開昭55-164824号、特開昭62-69263号、特開昭63-146038、特開昭63-163452号、特開昭62-153853号、特開昭63-146029号等に記載の化合物を用いることができる。

【0071】さらにV.N.R.Pillai,Synthesis,(1),1(1980)、A. Abad etal, Tetrahedron Lett.,(47)4555(1971)、D.H.R. Barton etal, J. Chem. Soc.,(C),329(1970)、米国特許第3,779,778号、欧州特許第126,712号等に記載の光により酸を発生する化合物も使用することができる。

【0072】上記活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の中で、特に有効に用いられるものについて以下に説明する。

(1) トリハロメチル基が置換した下記一般式 (PAG1) で表されるオキサゾール誘導体または一般式 (PAG2) で表されるS-トリアジン誘導体。

[0073]

【化21】

$$R^{202}$$
 $N-N$
 R^{201}
 C'
 C
 $C(Y)_3$
 $(Y)_3C$
 N
 $C(Y)_5$
 $(PAG2)$

【0074】式中、R201は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R202は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、R202は置換もしくは未置換のアリール基、アルケニル基、アルキル基、-C(Y)3をしめす。Yは塩素原子または臭素原子を示す。具体的には以下の化合物を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0075】 【化22】

50

CH=CH
CH=CH
N N

(PAG2-9) (PAG2-10)

【0078】(2)下記の一般式(PAG3)で表されるヨードニウム塩、または一般式(PAG4)で表されるスルホニウム塩。

【0079】 【化25】

Ar¹

$$I^{\oplus}$$
 Z^{\ominus}
 $R^{204} \xrightarrow{R^{205}} S^{\oplus}$
 R^{205}
(PAG3)
 R^{206}

【0080】ここで式Arl、Ar2は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。好ましい置換基としては、アルキル基、ハロアルキル基、シクロアルキル基、アリール基、アルコキシ基、ニトロ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、ヒロドキシ基、メルカプト基およびハロゲン原子が挙げられる。

【0081】R203、R204、R205は各々独立に、置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。好ましくは、炭素数6~14のアリール基、炭素数1~8のアルキル基およびそれらの置換誘導体である。好ましい置換基としては、アリール基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、炭素数1~8のアルキル基、ニトロ基、カルボキシル基、ヒロドキシ基およびハロゲン原子であり、アルキル基に対しては炭素数1~8のアルコキシ基、カルボキシル基、アルコシキカルボニル基である。

【0082】 Z-は対アニオンを示し、例えばBF4-、AsF6-、PF6-、SbF6-、SiF6²-、ClO4-、CF3SO3-等のパーフルオロアルカンスルホン酸アニ

44

オン、ペンタフルオロペンゼンスルホン酸アニオン、ナフタレン-1-スルホン酸アニオン等の縮合多核芳香族スルホン酸アニオン、アントラキノンスルホン酸 アニオン、スルホン酸基含有染料等を挙げることができるがこれらに限定されるものではない。

【0.0.8.3】 また R^{203} 、 R^{204} 、 R^{205} のうちの 2 つおよび A^{r_1} 、 A^{r_2} はそれぞれの単結合または置換基を介して結合してもよい。

【0084】具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0085]

[0086] 【化27】

É

46

$$(PAG3-5)$$

$$(PAG3-5)$$

$$(PAG3-6)$$

$$(PAG3-6)$$

$$(PAG3-7)$$

$$O_2N$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-8)$$

$$(PAG3-9)$$

$$H_3C$$

$$(PAG3-10)$$

$$H_3C$$

$$(PAG3-11)$$

$$(PAG3-12)$$

$$(PAG3-12)$$

$$(PAG3-13)$$

$$(PAG3-13)$$

$$(PAG3-13)$$

$$(CF_3SO_3 \ominus G)$$

$$(PAG3-16)$$

$$(PAG3-17)$$

$$(PAG3-18)$$

$$(PAG3-18)$$

$$(PAG3-18)$$

$$(PAG3-18)$$

【0087】 【化28】

$$F_{3}C \longrightarrow I^{\bigoplus} \longrightarrow CF_{3} \qquad CF_{3}SO_{3}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-14) \qquad PF_{6}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-15) \qquad PF_{6}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-16) \qquad PF_{6}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-17) \qquad PF_{6}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-18) \qquad PF_{6}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-18) \qquad PF_{6}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-19) \qquad CF_{3}SO_{3}^{\bigoplus}$$

$$(PAG3-20) \qquad (PAG3-20)$$

$$[0088]$$

(PAG4-7)

【0091】 【化32】

【化35】

52

【0095】 【化36】 54

(PAG4-34) 50 【0096】一般式(PAG3)、(PAG4)で示さ

55

れる上記オニウム塩は公知であり、例えばJ.W.Knapczyk etal, J.Am. Chem. Soc., 91, 145(1969)、A.L. Maycok etal, J. Org. Chem., 35, 2532, (1970)、E. Goethas etal, Bull. Soc. Chem. Belg., 73, 546, (1964)、H. M. Leicester、J. Ame. Chem. Soc., 51, 3587(1929)、J. V. Crivello etal, J. Polym. Chem. Ed., 18, 2677(1980)、米国特許第2,807,648号および同4,247,473号、特開昭53-101,331号等に記載の方法により合成することができる。

【0097】 (3) 下記一般式 (PAG5) で表される ジスルホン誘導体または一般式 (PAG6) で表される イミノスルホネート誘導体。

[0098]

【化37】

$$Ar^3 - SO_2 - SO_2 - Ar^4$$
 $R^{206} - SO_2 - O - N$ (PAG5) (PAG6)

【0099】式中、Ar3、Ar4は各々独立に置換もしくは未置換のアリール基を示す。R206は置換もしくは未置換のアルキル基、アリール基を示す。Aは置換もしくは未置換のアルキレン基、アルケニレン基、アリーレン基を示す。具体例としては以下に示す化合物が挙げられるが、これらに限定されるものではない。

[0100] [化38]

$$C_{1} \longrightarrow SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow C_{1}$$

$$(PAG5-1)$$

$$H_{3}C \longrightarrow SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow CH_{2}$$

$$(PAG5-2)$$

$$H_{3}CO \longrightarrow SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow CCH_{3}$$

$$(PAG5-3)$$

$$H_{3}C \longrightarrow SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow C_{1}$$

$$(PAG5-4)$$

$$F_{3}C \longrightarrow SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow CF_{3}$$

$$(PAG5-5)$$

$$GPAG5-6$$

$$H_{5}C_{2}O \longrightarrow SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow C_{1}$$

$$(PAG5-6)$$

$$H_{5}C_{2}O \longrightarrow SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow C_{1}$$

$$(PAG5-7)$$

$$SO_{2} - SO_{2} \longrightarrow C_{1}$$

$$(PAG5-8)$$

【0101】 【化39】

Ė

58

30

[0103]

【化41】

【化40】

$$\begin{array}{c}
O \\
N-O-SO_2
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
F \\
F
\end{array}$$

$$F$$

(PAG6-14)

$$N-0-SO_2$$
 F
 F
 F

(PAG6-15)

(PAG6-17)

H₃C

(PAG6-17)

(PAG6-18)

(PAG6-19)
【0106】これらの活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の添加量は、感光性組成物の全重量(塗布溶媒を除く)を基準として通常0.001~40重量%の範囲で用いられ、好ましくは0.01~20重量%、更に好ましくは0.1~5重量%の範囲で使用される。活性光線または放射線の照射により分解して酸を発生する化合物の添加量が、0.001重量%より少ないと感度が低くなり、また添加量が40重量%より多いとレジストの光吸収が高くなりすぎ、プロフ

ァイルの悪化や、プロセス (特にベーク) マージンが狭

くなり好ましくない。

【0107】 [6] 本発明に使用されるその他の成分 本発明のポジ型感光性組成物には、必要に応じて更に酸 分解性溶解阻止化合物、染料、可塑剤、界面活性剤、光 増感剤、有機塩基性化合物、及び現像液に対する溶解性 を促進させる化合物等を含有させることができる。本発 明のポジ型感光性組成物には、酸分解性溶解阻止化合物 が含有することが好ましい。これにより、露光、未露光 のアルカリ溶解性のディスクリミネーションが大きくな り、より解像度が優れるようになる。本発明で使用され る酸分解性溶解阻止化合物としては、例えば上記一般式 (X)、(XI)で示される酸分解性基を少なくとも1個 有する分子量3,000以下の低分子化合物である。特 に220 nm以下の透過性を低下させない為、Proceedi ng of SPIE, 2724, 355 (1996)に記載されているコール 酸誘導体の様な脂環族又は脂肪族化合物が好ましい。本 50 発明において、酸分解性溶解阻止化合物を使用する場

60

合、その添加量は感光性組成物の全重量(溶媒を除く)を基準として3~50重量%であり、好ましくは5~40重量%、より好ましくは10~35重量%の範囲である。

【0108】本発明で使用できる現像液に対する溶解促進性化合物としては、フェノール性OH基を2個以上、又はカルボキシ基を1個以上有する分子量1,000以下の低分子化合物である。カルボキシ基を有する場合は上記と同じ理由で脂環族又は脂肪族化合物が好ましい。これら溶解促進性化合物の好ましい添加量は、本発明の樹脂に対して2~50重量%であり、更に好ましくは5~30重量%である。50重量%を越えた添加量では、現像残渣が悪化し、また現像時にパターンが変形するという新たな欠点が発生して好ましくない。

【0109】このような分子量1000以下のフェノール化合物は、例えば、特開平4-122938、特開平2-28531、米国特許第4916210、欧州特許第219294等に記載の方法を参考にして、当業者に於て容易に合成することが出来る。フェノール化合物の具体例を以下に示すが、本発明で使用できる化合物はこれらに限定されるものではない。

【0110】レゾルシン、フロログルシン、2,3,4 ートリヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,4′ー テトラヒドロキシベンゾフェノン、2,3,4,3′, 4′,5′ーヘキサヒドロキシベンゾフェノン、アセト ンーピロガロール縮合樹脂、フロログルコシド、2, 4,2′,4′ーピフェニルテトロール、4,4′ーチ*

ここで、 R^{250} 、 R^{251} および R^{252} は、同一または異なり、水素原子、炭素数 $1\sim 6$ のアルキル基、炭素数 $1\sim 6$ のアミノアルキル基、炭素数 $1\sim 6$ のヒドロキシアルキル基または炭素数 $6\sim 2$ 0 の置換もしくは非置換のアリール基であり、ここで R^{254} と R^{255} は互いに結合して環を形成してもよい。

$$-N-C=N- \qquad \cdots (B)$$

$$=C-N=C- \qquad \cdots (C)$$

$$=C-N- \qquad \cdots (D)$$

$$R^{253}-C-N-C-R^{255} \qquad \cdots (E)$$

(式中、 \mathbb{R}^{253} 、 \mathbb{R}^{254} 、 \mathbb{R}^{256} および \mathbb{R}^{256} は、同一または異なり、炭素数 $1\sim6$ のアルキル基を示す)

62

*オビス(1,3-ジヒドロキシ)ベンゼン、2,21, 4, 4'ーテトラヒドロキシジフェニルエーテル、2, 2′, 4, 4′ーテトラヒドロキシジフェニルスルフォ キシド、2, 2', 4, 4' ーテトラヒドロキシジフェ ニルスルフォン、トリス (4-ヒドロキシフェニル) メ タン、1、1ービス(4ーヒドロキシフェニル)シクロ ヘキサン、4, 4- (α-メチルベンジリデン) ビスフ ェノール、 α , α , α ートリス (4ーヒドロキシフ ェニル) -1, 3, 5-トリイソプロピルベンゼン、 α , α' , α'' - トリス (4-ヒドロキシフェニル) -1-エチルー4-イソプロピルベンゼン、1,2,2-トリス (ヒドロキシフェニル) プロパン、1, 1, 2-トリス (3. 5ージメチルー4ーヒドロキシフェニル) プロパン、2, 2, 5, 5-テトラキス(4-ヒドロキ シフェニル) ヘキサン、1, 2ーテトラキス (4ーヒド ロキシフェニル) エタン、1、1、3-トリス (ヒドロ キシフェニル) ブタン、パラ $[\alpha, \alpha, \alpha', \alpha' - \tau]$ トラキス (4~ヒドロキシフェニル)]ーキシレン等を 挙げることができる。

2 【0111】本発明で用いることのできる好ましい有機 塩基性化合物とは、フェノールよりも塩基性の強い化合 物である。中でも含窒素塩基性化合物が好ましい。好ま しい化学的環境として、下記式(A)~(E)の構造を 挙げることができる

挙げることができる。 【0 1 1 2】 【化 4 4】

【0113】更に好ましい化合物は、一分子中に異なる 化学的環境の窒素原子を2個以上有する含窒素塩基性化 合物であり、特に好ましくは、置換もしくは未置換のア ミノ基と窒素原子を含む環構造の両方を含む化合物もし くはアルキルアミノ基を有する化合物である。好ましい 具体例としては、置換もしくは未置換のグアニジン、置 換もしくは未置換のアミノピリジン、置換もしくは未置 換のアミノアルキルビリジン、置換もしくは未置換のア ミノピロリジン、置換もしくは未置換のインダーゾル、 置換もしくは未置換のピラゾール、置換もしくは未置換 のピラジン、置換もしくは未置換のピリミジン、置換も しくは未置換のプリン、置換もしくは未置換のイミダゾ リン、置換もしくは未置換のピラゾリン、置換もしくは 未置換のピペラジン、置換もしくは未置換のアミノモル フォリン、置換もしくは未置換のアミノアルキルモルフ ォリン等が挙げられる。好ましい置換基は、アミノ基、 アミノアルキル基、アルキルアミノ基、アミノアリール 基、アリールアミノ基、アルキル基、アルコキシ基、ア シル基、アシロキシ基、アリール基、アリールオキシ 基、ニトロ基、水酸基、シアノ基である。特に好ましい 化合物として、グアニジン、1,1-ジメチルグアニジ ン、1,1,3,3,-テトラメチルグアニジン、2-アミノピリジン、3ーアミノピリジン、4ーアミノピリ ジン、2-ジメチルアミノピリジン、4-ジメチルアミ ノピリジン、2ージエチルアミノビリジン、2ー(アミ ノメチル) ピリジン、2-アミノ-3-メチルピリジ ン、2-アミノー4-メチルピリジン、2-アミノー5 -メチルピリジン、2-アミノー6-メチルピリジン、 3-アミノエチルピリジン、4-アミノエチルピリジ ン、3-アミノピロリジン、ピペラジン、N-(2-ア ミノエチル) ピペラジン、N-(2-アミノエチル) ピ ペリジン、4-アミノー2, 2, 6, 6-テトラメチル ピペリジン、4ーピペリジノピペリジン、2ーイミノピ ペリジン、1-(2-アミノエチル)ピロリジン、ピラ ゾール、3-アミノ-5-メチルピラゾール、5-アミ ノー3-メチルー1-p-トリルピラゾール、ピラジ ン、2-(アミノメチル)-5-メチルピラジン、ピリ ミジン、2, 4ージアミノピリミジン、4, 6ージヒド ロキシピリミジン、2-ピラゾリン、3-ピラゾリン、 $N-r \leq J \leq L \leq J \leq N - (2-r \leq J \leq L \leq L) \leq L$ ルフォリンなどが挙げられるがこれに限定されるもので

【0114】これらの含窒素塩基性化合物は、単独であるいは2種以上一緒に用いられる。含窒素塩基性化合物の使用量は、感光性樹脂組成物(溶媒を除く)100重量部に対し、通常、0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部である。0.001重量部未満では上記含窒素塩基性化合物の添加の効果が得られない。一方、10重量部を超えると感度の低下や非露光部の現像性が悪化する傾向がある。

はない。

64

【0115】好適な染料としては油性染料及び塩基性染料がある。具体的にはオイルイエロー#101、オイルイエロー#103、オイルピンク#312、オイルグリーンBG、オイルブルーBOS,オイルブルー#603、オイルブラックBY、オイルブラックBS、オイルブラックT-505(以上オリエント化学工業株式会社製)、クリスタルバイオレット(CI42555)、メチルバイオレット(CI42535)、ローダミンB(CI45170B)、マラカイトグリーン(CI42000)、メチレンブルー(CI52015)等を挙げることができる。

【0116】露光による酸発生率を向上させる為、さら に下記に挙げるような光増感剤を添加することができ る。好適な光増感剤としては、具体的にはベンゾフェノ ン、p, p'ーテトラメチルジアミノベンゾフェノン、 p. p'ーテトラエチルエチルアミノベンゾフェノン、 2-クロロチオキサントン、アントロン、9-エトキシ アントラセン、アントラセン、ピレン、ペリレン、フェ ノチアジン、ベンジル、アクリジンオレンジ、ベンゾフ 20 ラビン、セトフラビンーT、9、10-ジフェニルアン トラセン、9-フルオレノン、アセトフェノン、フェナ . ントレン、2ーニトロフルオレン、5ーニトロアセナフ テン、ベンゾキノン、2-クロロー4-ニトロアニリ ン、N-アセチル-p-ニトロアニリン、p-ニトロア ニリン、、N-アセチル-4-ニトロ-1-ナフチルア ミン、ピクラミド、アントラキノン、2-エチルアント ラキノン、2-tertープチルアントラキノン1, 2-ベ ンズアンスラキノン、3-メチル-1,3-ジアザー 1, 9-ベンズアンスロン、ジベンザルアセトン、1, 2ーナフトキノン、3,3'ーカルボニルービス(5, 7-ジメトキシカルボニルクマリン) 及びコロネン等で あるがこれらに限定されるものではない。また、これら の光増感剤は、光源の遠紫外光の吸光剤としても使用可 能である。この場合、吸光剤は基板からの反射光を低減 し、レジスト膜内の多重反射の影響を少なくさせること で、定在波改良の効果を発現する。

【0117】本発明の感光性組成物は、上記各成分を溶解する溶媒に溶かして支持体上に塗布する。ここで使用する溶媒としては、エチレンジクロライド、シクロペキ40 サノン、シクロペンタノン、2ーヘプタノン、γーブチロラクトン、メチルエチルケトン、エチレングリコールモノメチルエーテル、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、ピレエン、酢酸エチル、乳酸メチル、乳酸エチル、メトキシプロピオン酸エチル、ピルビン酸メチル、ピルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N,Nージメチルビン酸エチル、ピルビン酸プロピル、N,Nージメチル

リドン、テトラヒドロフラン等が好ましく、これらの溶 媒を単独あるいは混合して使用する。

【0118】上記溶媒に界面活性剤を加えることもでき る。具体的には、ポリオキシエチレンラウリルエーテ ル、ポリオキシエチレンステアリルエーテル、ポリオキ シエチレンセチルエーテル、ポリオキシエチレンオレイ ルエーテル等のポリオキシエチレンアルキルエーテル 類、ポリオキシエチレンオクチルフェノールエーテル、 ポリオキシエチレンノニルフェノールエーテル等のポリ オキシエチレンアルキルアリルエーテル類、ポリオキシ エチレン・ポリオキシプロピレンブロックコポリマー 類、ソルビタンモノラウレート、ソルビタンモノパルミ テート、ソルビタンモノステアレート、ソルビタンモノ オレエート、ソルビタントリオレエート、ソルビタント リステアレート等のソルビタン脂肪酸エステル類、ポリ オキシエチレンソルビタンモノラウレート、ポリオキシ エチレンソルビタンモノパルミテート、ポリオキシエチ レンソルビタンモノステアレート、ポリオキシエチレン ソルビタントリオレエート、ポリオキシエチレンソルビ タントリステアレート等のポリオキシエチレンソルビタ ン脂肪酸エステル類等のノニオン系界面活性剤、エフト ップEF301, EF303, EF352 (新秋田化成 (株) 製)、メガファックF171, F173 本インキ (株) 製)、フロラードFC430, FC43 1 (住友スリーエム (株) 製)、アサヒガードAG71 0, サーフロンS-382, SC101, SC102, SC103, SC104, SC105, SC106 (旭 硝子(株)製)等のフッ素系界面活性剤、オルガノシロ キサンポリマーKP341 (信越化学工業 (株) 製) や アクリル酸系もしくはメタクリル酸系 (共) 重合ポリフ ローNo. 75, No. 95 (共栄社油脂化学工業

(株) 製)等を挙げることができる。これらの界面活性 剤の配合量は、本発明の組成物中の固形分100重量部 当たり、通常、2重量部以下、好ましくは1重量部以下 である。これらの界面活性剤は単独で添加してもよい し、また、いくつかの組み合わせで添加することもでき る。

【0119】上記感光性組成物を精密集積回路素子の製造に使用されるような基板(例:シリコン/二酸化シリコン被覆)上にスピナー、コーター等の適当な塗布方法により塗布後、所定のマスクを通して露光し、ベークを行い現像することにより良好なレジストパターンを得ることができる。ここで露光光としては、好ましくは250nm以下、より好ましくは220nm以下の波長の遠紫外線である。具体的には、KrFエキシマレーザー(248nm)、ArFエキシマレーザー(193nm)、F2エキシマレーザー(157nm)、X線、電子ビーム等が挙げられる。

【0120】本発明の感光性組成物の現像液としては、 水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、炭酸ナトリウム、 66

ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア 水等の無機アルカリ類、エチルアミン、パープロピルア ミン等の第一アミン類、ジエチルアミン、ジーnープチ ルアミン等の第三アミン類、トリエチルアミン、メチル ジエチルアミン等の第三アミン類、ジメチルエタノール アミン、トリエタノールアミン等のアルコールアミン 類、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエ チルアンモニウムヒドロキシド、テトウエ チルアンモニウムヒドロキシドの第四級アンモニウム 塩、ピロール、ピヘリジン等の環状アミン類等のアルカ リ性水溶液を使用することができる。更に、上記アルカ リ性水溶液にアルコール類、界面活性剤を適当量添加し て使用することもできる。

[0121]

50 た。

【実施例】以下、本発明を実施例により更に詳細に説明 するが、本発明の内容がこれにより限定されるものでは ない。

「合成例1(構造例 (a1)の原料モノマーの合成)]無水マレイン酸9.8g (0.10モル)、1ーアダマンタノール15.2g (0.10モル)をDMF200m1に溶解した。この溶液にN,Nージメチルアミノピリジン12.3g (0.10モル)のDMF50m1溶液を、室温にて撹拌下添加した。更に60℃にて5時間加熱撹拌させた。放冷後、塩酸にて中和し、反応溶液をイオン交換水3Lに激しく撹拌しながら投入した。析出した粘調固体を水洗し、カラムクロマトグラフィー(充填剤:シリカゲル、溶離液:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)にて精製した。白色粉体12.6gを得た。NMR測定により、この粉体が本発明の構造例 (a1)の原料モノマーであることを確認した。

【0122】 [合成例2 (構造例 (a3) の原料モノマーの合成)] 合成例1の1ーアダマンタノールの代わりに、1ーアダマンタンメタノール16.6g(0.10モル)を使用し、その他は合成例1と同様にして白色粉体14.2gを得た。NMR測定により、この液体が本発明の構造例 (a3) の原料モノマーであることを確認した。

【0123】 [合成例3(構造例(a5)の原料モノマーの合成)] 合成例1の1ーアダマンタノールの代わりに、2ーメチルー2ーアダマンタノール16.6g(0.10モル)を使用し、その他は合成例1と同様にして白色粉体12.7gを得た。NMR測定により、この粉体が本発明の構造例(a5)の原料モノマーであることを確認した。

【0124】 [合成例4 (構造例 (a7) の原料モノマーの合成)] 合成例1の1ーアダマンタノールの代わりに、1ーアミノアダマンタン15.1g (0.10モル)を使用し、その他は合成例1と同様にして淡褐色粉体16.4gを得た。NMR測定により、この粉体が本発明の構造例 (a7) の原料モノマーであることを確認し

【0125】 [合成例5(構造例(a30)の原料モノマーの合成)] 無水イタコン酸11.2g(0.10モル)、1ーアダマンタンメタノール16.6g(0.10モル)をDMF200mlに溶解した。この溶液にN,Nージメチルアミノビリジン12.3g(0.10モル)のDMF50ml溶液を、室温にて撹拌下添加した。更に60℃にて5時間加熱撹拌させた。放冷後、塩酸にて中和し、反応溶液をイオン交換水3Lに激しく撹拌しながら投入した。析出した粘調固体を水洗し、カラムクロマトグラフィー(充填剤:シリカゲル、溶離を15.2gを得た。NMR測定により、この粉体が本発明の構造例(a30)の原料モノマーであることを確認した。

【0126】 [合成例6(構造例(al5)の原料モノマーの合成)] 合成例1にて得られた本発明の構造例(al)の原料モノマー12.5g(0.050モル)、ジヒドロピラン6.3g(0.075モル)をTHF200mlに溶解した。この溶液に触媒として2ーエチルへキシルリン酸エステル0.05gを添加し、50℃にて8時間加熱撹拌させた。トリエチルアミンにて触媒を中和した後、減圧蒸留にて精製し、無色液体11.7gを得た。NMR測定により、この液体が本発明の構造例(al5)の原料モノマーであることを確認した。

【0127】 [合成例7(構造例(a47)の原料モノマーの合成)] 合成例5にて得られた本発明の構造例(a30)の原料モノマー13.9g(0.050モル)、エチルビニルエーテル5.4g(0.075モル)をTHF200m1に溶解した。この溶液に触媒として2ーエチルヘキシルリン酸エステル0.05gを添加し、50℃にて8時間加熱撹拌させた。トリエチルアミンにて触媒を中和した後、減圧蒸留にて精製し、無色液体12.2gを得た。NMR測定により、この液体が本発明の構造例(a47)の原料モノマーであることを確認した。

【0128】 [合成例8 (構造例 (b7) の原料モノマーの合成)] 無水メタクリル酸15.4g(0.10モル)、3-ヒドロキシー3-メチルブテノール8.6g(0.10モル)をTHF200mlに溶解した。この溶液にN, N-ジメチルアミノピリジン12.3g

(0.10モル)のDMF50ml溶液を、室温にて撹拌下添加した。更に撹拌下、5時間加熱環流させた。放冷後、反応溶液をイオン交換水3Lに激しく撹拌しながら投入し、酢酸エチル300mlにて抽出した。酢酸エチル溶液を水洗し硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。減圧蒸留にて精製し、無色液体11.4gを得た。NMR測定により、この液体が本発明の構造例(b7)の原料モノマーであることを確認した。

【0129】 [合成例9 (構造例 (b15) の原料モノマーの合成)] メタクリル酸17.2g(0.20モル)、ジヒドロピラン25.2g(0.30モル)をT

68

HF200mlに溶解した。この溶液に触媒として2-エチルへキシルリン酸エステル0.1gを添加し、50 \mathbb{C} にて8時間加熱撹拌させた。トリエチルアミンにて触媒を中和した後、減圧蒸留にて精製し、無色液体26.5gを得た。NMR測定により、この液体が本発明の構造例($\mathbb{b}15$)の原料モノマーであることを確認した。 \mathbb{C} 0130 \mathbb{C} 1 \mathbb{C} 2 \mathbb{C} 3 \mathbb{C} 4 \mathbb{C} 5 \mathbb{C} 6 \mathbb{C} 6 \mathbb{C} 7 \mathbb{C} 9 \mathbb{C}

【0130】 [合成例10 (構造例 (b18) の原料モノマーの合成)] 合成例9のジヒドロピランの代わりに、エチルビニルエーテル21.6 (0.30モル)を使用し、その他は合成例9と同様にして無色液体24.5gを得た。NMR測定により、この液体が本発明の構造例(b18)の原料モノマーであることを確認した。

【0131】 [合成例11 (構造例 (b20) の原料モノマーの合成)] メタクリル酸17.2g (0.20モル)、2ーメトキシエトキシメチルクロリド24.9g (0.20モル)をDMAc200mlに溶解した。トリエチルアミン20.3gを添加し、90℃にて7時間加熱撹拌させた。放冷後、反応溶液をイオン交換水3Lに激しく撹拌しながら投入し、酢酸エチル300mlにて抽出した。酢酸エチル溶液を水洗し硫酸マグネシウムで乾燥した後、減圧下濃縮した。カラムクロマトグラフィー(充填剤:シリカゲル、溶離液:ヘキサン/酢酸エチル=3/1)にて精製し、無色液体13.4gを得た。NMR測定により、この液体が本発明の構造例(b20)の原料モノマーであることを確認した。

【0132】 [合成例12 (構造例 (al) / (bl) /ア クリロニトリルから成る本発明の樹脂の合成)]上記合 成例にて得られた構造例 (al) の原料モノマー12.5 $g(0.050 \pm h) kt - 7 \pm h \times 9 \pm 0 + 1 = 1.$ 84g(0.020モル)、更にアクリロニトリル1. 59g(0.030モル)を加え、1-メトキシー2-プロパノール60mlに溶解した。窒素気流及び撹拌 下、70℃にて重合開始剤2,2'-アゾビス(2,4 - ジメチルバレロニトリル) (和光純薬工業(株)製; 商品名 V-65) 100 mgを添加した。反応開始 2時 間及び4時間後に同開始剤各々100mgを追加した。 更に3時間反応後、90℃に昇温し撹拌を1時間続け た。反応液を放冷後、イオン交換水/メタノール (1/ 1) 1し中に激しく撹拌しながら投入することにより、 ポリマーを析出させた。得られたポリマーを減圧下、4 0℃にて乾燥し、本発明の樹脂(p-1) 1 4. 6 g を得 た。GPCにて分子量を測定したところ、重量平均(M w:ポリスチレン換算) で19.5×103 (分散度 (Mw/Mn) 2. 5) であった。

【0133】 [合成例13 (構造例 (al5) / アクリロニトリルから成る本発明の樹脂の合成)] 上記合成例にて得られた構造例 (al5) の原料モノマー8.36g (0.025モル) にアクリロニトリル1.32g (0.025モル) を加え、1-メトキシー2ープロバノール30mlに溶解した。窒素気流及び撹拌下、70

でにて重合開始剤 2, 2'-アゾビス (2, 4-ジメチルバレロニトリル) (和光純薬工業 (株) 製;商品名 V-65) 50 mgを添加した。反応開始 2時間及び 4時間後に同開始剤各々50 mgを追加した。更に 3時間反応後、90 でに昇温し撹拌を1時間続けた。反応液を放冷後、イオン交換水/メタノール (1/1) 0.5 Lに激しく撹拌しながら投入することにより、ポリマーを析出させた。得られたポリマーを減圧下、40 でにて乾燥し、本発明の樹脂 (p-2) 8.7 gを得た。GPCにて分子量を測定したところ、重量平均 (Mw:ポリスチレン換算)で22.4×103 (分散度 (Mw/Mn)2.7)であった。

【0134】 [合成例14 (構造例 (a17) から成る本発明の樹脂の合成)] 構造例 (a17) の原料モノマー32.2g (0.100モル)を、1ーメトキシー2ープロピルアセテート80mlに溶解した。以下合成例12と同様に反応、後処理をして本発明の樹脂 (p-3)22.6gを得た。GPCにて分子量を測定したところ、重量平均 (Mw:ポリスチレン換算)で26.4×103 (分散度 (Mw/Mn)2.5)であった。

【0135】 [合成例15 (構造例 (a9) / (b7) / (c2) から成る本発明の樹脂の合成)] 構造例 (a9) / (b7) の原料モノマー各々13.9g (0.050モル) / 5.40g (0.035モル) にメタクリル酸1.29g (0.015モル) 加え、1ーメトキシー2ープロパノール60m1に溶解した。以下合成例12と同様に反応、後処理をして本発明の樹脂 (p-4) 17.8gを得た。GPCにて分子量を測定したところ、重量平均 (Mw:ポリスチレン換算) で21.3×10

70

3 (分散度 (Mw/Mn) 2. 9) であった。

【0136】 [合成例16 (構造例 (a2) / (a17) か ら成る本発明の樹脂の合成)]構造例(a2)の原料モノ マー25.0g(0.100モル)を1-メトキシー2 ープロパノール60mlに溶解した。以下合成例12と 同様に反応、後処理をして構造例 (a2) から成る樹脂 2 1.8gを得た。この樹脂12.5gにエチルビニルエ ーテル3.24g(0.045モル)を加え、THF2 00mlに溶解した。この溶液に触媒として2-エチル ヘキシルリン酸エステルO. 05gを添加し、50℃に て8時間加熱撹拌させた。トリエチルアミンにて触媒を 中和した後、イオン交換水/メタノール(1/1)1L 中に激しく撹拌しながら投入することにより、ポリマー を析出させた。得られたポリマーを減圧下、40℃にて 乾燥し、本発明の樹脂 (p-5) 14. 4gを得た。NM R測定により、エチルビニルエーテル付加体 ((al7) で示される構造)が82モル%であることを確認した。 またGPCにて分子量を測定したところ、重量平均(M w:ポリスチレン換算)で27. 4×103 (分散度 (Mw/Mn) 2. 6) であった。

【0137】 [合成例17~33 (前記構造単位を有する本発明の樹脂の合成)] 以下合成例12~15と同様にして、下記表1に示す繰り返し構造単位の原料モノマーを用い、本発明の樹脂を合成した。使用した構造単位、その原料モノマー仕込みモル比、及び生成した樹脂の重量平均分子量を合わせて表1に示す。

[0138]

【表1】

合成例	本発明の樹脂	使用した構造単位 (モル%比)	重量平均分子量 (分散度)
1 7	(p-6)	(a3) / (a19) /アクリロニトリル (10/60/30)	24.6×10 ³ (2.6)
18	(p-7)	(a5) / (a24) (25/75)	28.4×10^{3} (2.5)
1 9	(p-8)	(a9) / (b10) / (c14) (60/25/15)	19.8×10 ³ (2.6)
20	(p-9)	(al1) / (b2) / (c2) (60/25/15)	24. 2×10 ³ (2. 6)
2 1	(p-10)	(al4) / (bl8) /アクリロニトリル (55/15/30)	(2.7)
2 2	(p-11)	(a16) / (c14) (75/25)	27. 5×10 ³ (2. 5)
2 3	(p-12)	(al7) /アクリロニトリル (70/30)	26.3×10 ³ (2.7)
2 4	(p-13)	(a18) / (c12) /アクリロニトリル (6 0 / 7 / 3 3)	29.6×10 ³ (2.9)
2 5	(p-14)	(a28) / (a42) (25/75)	31. 9×10 ³ (2. 6)
2 6	(p-15)	(a30) / (a46) /アクリロニトリル (2 0 / 5 0 / 3 0)	25. 4×10 ³ (2. 7)
2 7	(p-16)	(a32) / (a49) (3 0 / 7 0)	32.5×10^3 (2.6)
2 8	(p-17)	(a35) / (b6) / (c3) (63/30/7)	27.8×10 ³ (2.7)
2 9	(p-18)	(a37) / (b14) / (c2) (60/25/15)	23.7×10 ³ (2.6)
30	(p-19)	(a39) / (b10) / (c3) (63/30/7)	27.1×10 ³ (2.6)
3 1	(p-20)	(a43) / (c3) /アクリロニトリル (60/7/33)	26.5×10 ³ (2.7)
3 2	(p-21)	(a55) / (b28) / (c18) (60/25/15)	29.8×10 ³ (2.8)
3 3	(p-22)	(a57) / (b30) /アクリロニトリル (50/25/25)	24. 9×10 ³ (2. 7)

【0139】 [実施例1 (溶剤溶解性の測定)]上記合 成例で得られた本発明の樹脂 (p-1) ~ (p-22) 及び下 記比較例用ポリマー(A)各1.0gをプロピレングリ コールモノメチルエーテルアセテート4.0g及び乳酸 エチル/エトキシプロピオン酸エチル (重量比6/4) 4.0gに添加し、十分に撹拌した後5℃にて3日間放 置した。放置後の析出物の有無を濁度計にて測定するこ とにより、両溶剤に対する本発明の樹脂と比較例用ポリ マー(A)の溶解性を調べた。その結果、本発明の樹脂 においても析出物が認められず、十分な溶剤溶解性を有 することを確認した。一方、比較例用ポリマー(A)の 場合、5℃での経時後、樹脂の析出が認められた。 比較例用ポリマー (A):1-アダマンチルメタクリレ ート/tープチルメタクリレート/メタクリル酸 (モル 比;60/20/20、重量平均分子量31.5×10 3、分散度 2.9)

【0140】 [実施例2(光学濃度の測定)] 上記合成例で得られた本発明の樹脂1.0gとトリフェニルスルホニウムのトリフレート塩0.03gをプロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート4.5gに溶解し、0.2μmのテフロンフィルターにより濾過した。スピンコーターにて石英ガラス基板上に均一に塗布し、100℃で90秒間ホットプレート上で加熱乾燥を行い、1μmのレジスト膜を形成させた。得られた膜の光学吸収を紫外線分光光度計にて測定したところ、193

nmの光学濃度は表2に示す通りであった。

[0 1 4 1]

【表 2】

表 2. 本発明の樹脂の光学濃度測定結果

2001 13011 1301 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
本発明の樹脂	193nmの光学漢度 (/μm)	
(p-1)	0.33	
(p-2)	0.34	
(p-4)	0.35	
(p-8)	0.33	
(p-9)	0.34	
(p-10)	0.36	
(p-13)	0.34	
(p-15)	0.34	
(p-16)	0.37	
(p-18)	0.36	
(p-20)	0.35	
(p-22)	0.37	
ポリ (ヒドロキシスチレン) (比較例)	1.5以上	

【0142】表2の結果から、本発明の樹脂の光学濃度 測定値は比較例のポリ (ヒドロキシスチレン) の値より 小さく、193nm光に対し十分な透過性を有すること が判る。

50 【0143】〔実施例3(耐ドライエッチング性の測

定)〕上記合成例で得られた本発明の樹脂及び上記比較例用ポリマー(A)各1.0gをプロビレングリコールモノメチルエーテルアセテート4.5gに溶解し、0.2μmのテフロンフィルターにより濾過した。スピンコーターにてシリコン基板上に均一に塗布し、100℃で90秒間ホットプレート上で加熱乾燥を行い、0.7μmのレジスト膜を形成させた。得られた膜をULVAC製リアクティブイオンエッチング装置(CSE-1110)を用いて、CF4/O2(8/2)のガスに対するエッチング速度を測定したところ、表3に示す通りであった(エッチング条件:Power=500W、Presure=4.6Pa、GasFlow Rate=10sccm)。

[0144]

【表3】

表3. 本発明の樹脂の耐ドライエッチング速度測定結果

3CO: 1-75-77-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-71-	
本発明の樹脂	エッチング速度 (A/min)
(p-3)	640
(p-5)	630
(p-6)	670
(p-7)	620
(p-8)	690
(p-9)	700
(p-11)	670
(p-12)	680
(p-14)	630
(p-16)	640
(p-17)	700
(p-19)	710
(p-20)	690
比較例用ポリマー(A)	780
ポリ(メチルメタクリレート) (比較例)	1 2 5 0

【0145】表3の結果から、本発明の樹脂のエッチン グ速度は比較例のポリ(メチルメタクリレート)及び比

74

グ速度は比較例のポリ (メチルメタクリレート) 及び比 較例用ポリマー (A) の値より小さく、十分な耐ドライ

エッチング性を有することが判る。

【0146】 [実施例4 (画像評価-1-)] 上記合成 例で得られた本発明の樹脂1.0gとトリフェニルスル ホニウムのトリフレート塩0、03gをプロピレングリ コールモノメチルエーテルアセテート4.5gに溶解 し、0.2μmのテフロンフィルターにより濾過した。 10 スピンコーターにてヘキサメチルジシラザン処理を施し たシリコン基板上に均一に塗布し、100℃で90秒間 ホットプレート上で加熱乾燥を行い、0. 4μmのレジ スト膜を形成させた。このレジスト膜に対し、KrFエ キシマーレーザーステッパー (NA=0.42;248)nm)を使用してパターン露光し、露光後直ぐに110 ℃で60秒間ホットプレート上で加熱した。更に2.3 8%テトラメチルアンモニウムヒドロオキサイド水溶液 で23℃下60秒間浸漬現像し、30秒間純水にてリン スした後、乾燥した。この結果、表4に示した感度、解 20 像度にて、レジスト膜の露光部のみが溶解除去された良 好なポジ型のパターンを形成した。ここで、パターン形 状は、得られたパターンを走査型電子顕微鏡にて観察 し、矩形なものを良好とした。感度は、0.35μmの マスクパターンを再現する露光量をもって定義した。解 像度は、0.35μmのマスクパターンを再現する露光 量での限界解像力をもって定義した。

【0147】 【表4】

表4. 本発明の樹脂を使用したレジスト膜の感度、解像度及びパターンの形状

使用した本発明の樹脂	感度 (mJ/cm ²)	解像度 (µm)	パターンの形状
(p-2)	2 8	0.30	良好
(p-5)	2 6	0.28	良好
(p-7)	3 2	0.28	良好
(p-10)	2 5	0.30	良好
(p-11)	3 3	0.30	良好
(p-12)	2 8	0.28	良好
(p-14)	3 2	0.28	良好
(p-16)	2 7	0.28	良好
(p-18)	3 1	0.28	良好
(p-21)	3 4	0.30	良好

【0148】表4の結果から、本発明の樹脂を使用した 50 レジストは、高感度で解像度が良好である。またパター

ン形状が良好であることが判る。

【0149】 〔実施例5(画像評価-2-)〕 実施例4 で得られた0.4 μ mのレジスト膜上に、石英板上にクロムでパターンを描いたマスクを密着させ、ArFエキシマーレーザー光(193 n m)を照射した。露光後直ぐに110℃で60秒間ホットプレート上で加熱した。更に2.38%テトラメチルアンモニウムヒドロオキサイド水溶液で23℃下60秒間浸漬現像し、30秒間純 *

7€

*水にてリンスした後、乾燥した。この結果、表5に示した感度、解像度にて、レジスト膜の露光部のみが溶解除去された良好なポジ型のパターンを形成した。ここで、感度、解像度及びパターン形状は前記と同様に評価した。

【0150】 【表5】

表 5 . 本発明の樹脂を使用したレジスト膜の密度、解像度及びパターンの形状

使用した本発明の樹脂	感度 (mJ/cm²)	解像度 (μm)	パターンの形状
(p-2)	3 2	0.25	良好
(p-5)	3 1	0.25	良好
(p-7)	3 6	0.25	良好
(p-10)	2 9	0.25	良好
(p-11)	37	0.25	良好
(p-12)	3 3	0.25	良好
(p-14)	3 7	0.25	良好
(p-16)	3 2	0.25	良好
(p-18)	3 5	0.25	良好
(p-21)	3 9	0.25	良好

【0151】表5の結果から、本発明の樹脂を使用したレジストは、ArFエキシマーレーザー光に対しても良好な感度、解像度を示し、ポジ型のパターンを形成することが判る。

[0152]

【発明の効果】以上に示したことから明らかな様に本発明の樹脂においては、通常使用されるレジスト溶剤に対する溶解性が良好である。また本発明の樹脂を使用した

レジストは、250 n m以下、特に220 n m以下の遠 紫外光に対し高い透過性を有し、且つ耐ドライエッチン グ性が良好である。更に250 n m以下、特に220 n m以下の遠紫外光(特にArFエキシマーレーザー光) を露光光源とする場合、高感度、高解像度、且つ良好な パターシプロファイルを示し、半導体素子製造に必要な 微細パターンの形成に有効に用いることが可能である。